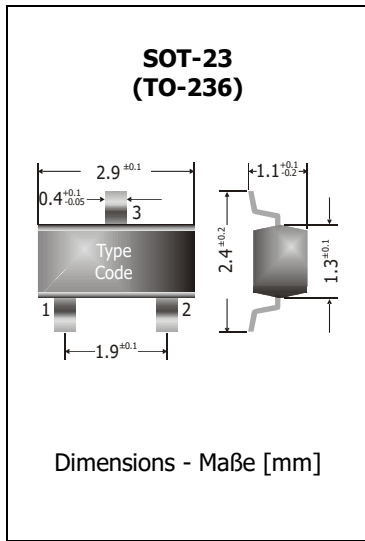


<b>BAS40, BAS40-04, BAS40-05, BAS40-06</b> <b>SMD Small Signal Schottky Diodes</b> <b>SMD Kleinsignal-Dioden</b>	<b>I<sub>FAV</sub></b> = 200 mA	<b>V<sub>RRM</sub></b> = 40 V
	<b>V<sub>F1</sub></b> < 0.38 V	<b>I<sub>FSM</sub></b> = 600 mA
	<b>T<sub>jmax</sub></b> = 150°C	<b>t<sub>rr</sub></b> < 5 ns

Version 2017-01-25



**Typical Applications**

Signal processing, High-speed switching, Polarity protection Commercial grade <sup>1)</sup>

**Features**

Very high switching speed  
 Low junction capacitance  
 Low leakage current  
 Compliant to RoHS, REACH, Conflict Minerals <sup>1)</sup>

**Mechanical Data <sup>1)</sup>**

Taped and reeled  
 Weight approx.  
 Solder & assembly conditions



3000 / 7"  
 0.01 g  
 260°C/10s  
 MSL = 1

**Typische Anwendungen**

Signalverarbeitung, Schnelles Schalten, Verpolschutz Standardausführung <sup>1)</sup>

**Besonderheiten**

Extrem schnelles Schalten  
 Niedrige Sperrschicht-Kapazität  
 Niedriger Sperrstrom  
 Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien <sup>1)</sup>

**Mechanische Daten <sup>1)</sup>**

Gegurtet auf Rolle  
 Gewicht ca.  
 Löt- und Einbaubedingungen

<b>BAS40</b> Single Diode  1 = A 2 = n. c. 3 = C Type Code 43	<b>BAS40-04</b> Series Connection  1 = A1 2 = C2 3 = C1/A2 Type Code 44
<b>BAS40-05</b> Common Cathode  1 = A1 2 = A2 3 = C1/C2 Type Code 45	<b>BAS40-06</b> Common Anode  1 = C1 2 = C2 3 = A1/A2 Type Code 46

**Maximum ratings <sup>2)</sup>**

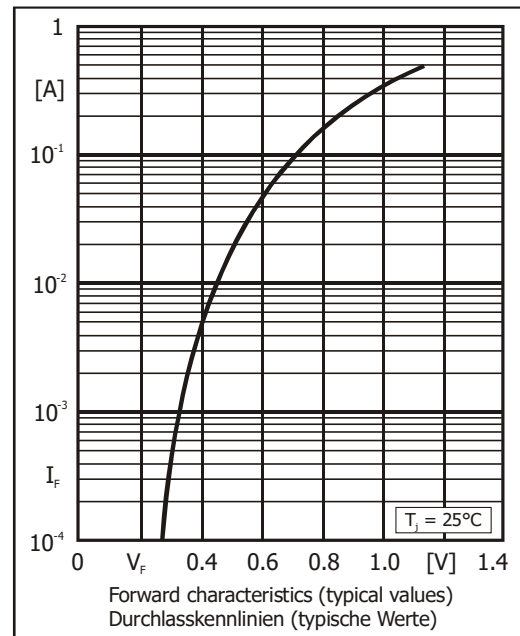
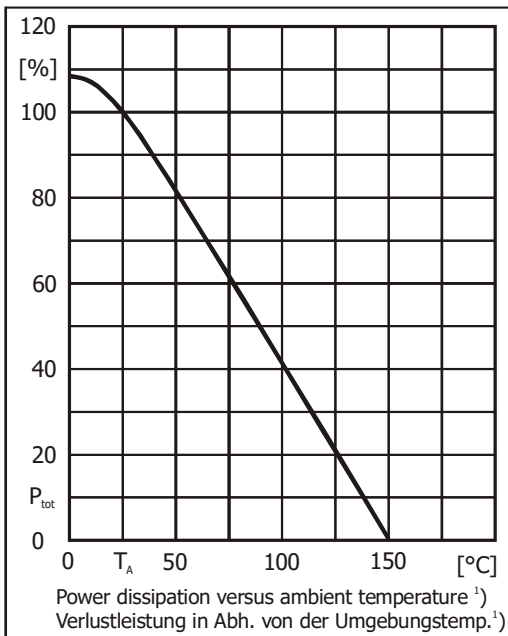
**Grenzwerte <sup>2)</sup>**

Power dissipation – Verlustleistung <sup>3)</sup>		P <sub>tot</sub>	310 mW <sup>4)</sup>
Max. average forward current – Dauergrenzstrom	DC	I <sub>FAV</sub>	200 mA <sup>4)</sup>
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom		I <sub>FRM</sub>	300 mA <sup>4)</sup>
Non repetitive peak forward surge current – Stoßstrom-Grenzwert	t <sub>p</sub> ≤ 1 s	I <sub>FSM</sub>	600 mA
Repetitive peak reverse voltage – Periodische Spitzensperrspannung		V <sub>RRM</sub>	40 V
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T <sub>j</sub>	-55...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T <sub>s</sub>	-55...+150°C

1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book  
 Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches  
 2 T<sub>A</sub> = 25°C and per diode, unless otherwise specified – T<sub>A</sub> = 25°C und pro Diode, wenn nicht anders angegeben  
 3 Total power dissipation of both diodes – Summe der Verlustleistungen beider Dioden  
 4 Mounted on P.C. board with 3 mm<sup>2</sup> copper pad at each terminal  
 Montage auf Leiterplatte mit 3 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss

**Characteristics**
**Kennwerte**

Forward voltage Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 1\text{ mA}$ $I_F = 40\text{ mA}$	$V_F$	$< 380\text{ mV}$ $< 1000\text{ mV}$
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = 30\text{ V}$	$I_R$	$< 200\text{ nA}^{1)}$
Breakdown voltage Abbruch-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_R = 10\text{ }\mu\text{A}$	$V_{BR}$	$> 40\text{ V}^{1)}$
Junction capacitance Sperrschichtkapazität	$V_R = 0\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$		$C_T$	$< 5\text{ pF}$
Reverse recovery time Sperrverzug	$I_F = 10\text{ mA}$ über/through $I_R = 10\text{ mA}$ bis/to $I_R = 1\text{ mA}$		$t_{rr}$	$< 5\text{ ns}$
Thermal resistance junction to ambient Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung			$R_{thA}$	$< 400\text{ K/W}^{2)}$



**Disclaimer:** See data book page 2 or [website](#)  
**Haftungsausschluss:** Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

- 1 Tested with pulses  $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$ , duty cycle  $\leq 2\%$   
Gemessen mit Impulsen  $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$ , Schaltverhältnis  $\leq 2\%$
- 2 Mounted on P.C. board with  $3\text{ mm}^2$  copper pad at each terminal  
Montage auf Leiterplatte mit  $3\text{ mm}^2$  Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss